(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-353211 (P2002-353211A)

(43)公開日 平成14年12月6日(2002.12.6)

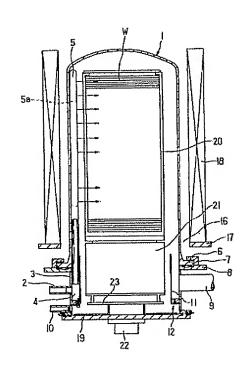
(51) Int Cl. ⁷	酸別記号	F I 7-73-ド(参考	r)
H01L 21/3		HO1L 21/31 E 4K061	
F27B 5/1		F 2 7 B 5/16 4 K 0 6 3	
F27D 7/0		F27D 7/06 B 5F045	
H01L 21/2		H01L 21/22 511S	
21/3		21/324 R	
		審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 7)
(21)出願番号	特願2001-158477(P2001-158477)	(71) 出願人 000219967	
(Day particular)		東京エレクトロン株式会社	
(22)出顧日	平成13年5月28日(2001.5.28)	東京都港区赤坂5丁目3番6号	
1		(72) 発明者 山本 博之	
		東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBS	
		送センター 東京エレクトロン株式会社	社内
		(72)発明者 牛窪 繁博	
		東京都港区赤坂五丁目3番6号 TB	
		送センター 東京エレクトロン株式会社	在內
		(74)代型人 100081293	
		弁理士 小林 哲男	
		最終頁に	2舵く

(54) 【発明の名称】 熱処理装置とその熱処理方法

(57)【要約】

【課題】 ガス導入管の基端部側における処理ガスの凝縮を確実に防ぎ、また、ガス導入管の位置精度と再現性を良好ならしめた熱処理装置と熱処理方法を提供すること。

【解決手段】 被処理体Wを収容した処理容器 1 内にガス導入管5により処理ガスを導入して熱処理を施すようにした熱処理装置において、処理容器 1 内に設けたガス導入管5の基端位置に保持体4を設け、この保持体4 に熱伝導率の高い熱伝導部材2 9 を挿着し、この熱伝導部材2 9 は、処理容器 1 内を加熱する熱エネルギの伝達位置に配設された熱処理装置である。この場合、熱伝導部材2 9 は、熱伝導性に優れているSiCを用いる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 被処理体を収容した処理容器内にガス導 入管により処理ガスを導入して熱処理を施すようにした 熱処理装置において、前記処理容器内に設けたガス導入 管の基端部を保持し、との保持位置に熱伝導率の高い熱 伝導部材を設け、との熱伝導部材は、前記処理容器内を 加熱する熱エネルギの伝達位置に配設されたことを特徴 とする熱処理装置。

1

【請求項2】 前記ガス導入管の基端部にガス通路を有 する金属製又は石英、SiC等のセラミック製の保持体 10 ンジェクタをOリングを介してガス導入部に挿入接続 を設け、との保持体に前記熱伝導部材の下端部を装着し た請求項1に記載の熱処理装置。

【請求項3】 前記熱伝導部材は、処理容器内を熱処理 温度まで加熱しても金属汚染のおそれがなく.熱伝導率 の高い材料を用いた請求項1又は2に記載の熱処理装

【請求項4】 前記熱伝導部材は、SiC製とした請求 項3に記載の熱処理装置。

【請求項5】 前記処理容器の下端部に金属製又は非金 属製のマニホールドを設け、とのマニホールドに設けた 20 ガス導入部に前記保持体の接続部を接続すると共に、前 記保持体に形成した挿着部に前記熱伝導部材の下端部を 抑着した請求項1乃至4の何れかに記載の熱処理装置。

【請求項6】 前記熱伝導部材をロッド又はパー形状等 の棒状物に形成し、この熱伝導部材を前記保持体の挿着 部に立設すると共に、との熱伝導部材は、前記ガス導入 **管の長さ方向に近接させた請求項5に記載の熱処理装** 置。

【請求項7】 被処理体を収容した処理容器内にガス導 入管により処理ガスを導入して熱処理を施すようにした 30 熱処理方法において、前記ガス導入管の基端部に設けた 熱伝導率の高い熱伝導部材に対して、前記処理容器内を 加熱する熱エネルギを熱伝達させ、更に、この熱伝導部 材の熱伝導によりガス導入管の基端部を加熱するように したことを特徴とする熱処理方法。

【請求項8】 前記ガス導入管の基端部にガス通路を有 する金属製又は非金属製の保持体を設け、この保持体に 枠状の熱伝導部材を装着して、熱伝導部材の熱伝導によ り保持体を加熱するようにした請求項7に記載の熱処理 方法。

【請求項9】 前記熱伝導部材は、SiC製とした請求 項7又は8に記載の熱処理方法。

(発明の詳細な説明)

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、縦型の熱処理装置 とその熱処理方法に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体デバイスの製造においては、半導 体ウエハ等の被処理体に酸化、拡散。CVD、アニール 等の処理を施すために、縦型熱処理装置が用いられてい 50 すようにした熱処理装置において、前記処理容器内に設

る。この縦型熱処理装置は、半導体ウエハを収容した処 理容器内にガス導入部から石英製のガス導入管(インジ ェクタ)を介して処理ガスを半導体ウエハに供給するよ うに構成されている。

[0003] との縦型熱処理装置の一例として、処理容 器の下端部に金属製のマニホールドを設け、このマニホ ールドには、ガス供給配管を接続して処理ガスを導入す るためのガス導入部を設けたものが知られている。更 に、とのガス導入部には、基端部をし字状に折曲したイ し、インジェクタは、処理容器内に立設してウエハに処 理ガスを供給するようにしている。

[0004]しかし、との従来の縦型熱処理装置は、処 理ガスとして例えば金属 D P M 錯体を溶剤に溶かした材 料或は室温で液体となる有機金属材料といった沸点の比 較的高い材料を気化させて供給すると、ガス導入管に接 続したインジェクタの基端部が比較的低温であるため. 処理ガスが凝縮し易く、発塵の原因となるおそれがあっ た。また、インジェクタの管壁に分散口を形成した分散 型インジェクタは、ウエハ間への均等な処理ガスの供給 が望まれるものであるが、従来のこの種のインジェクタ は、上述のように、その基端部側をOリングを介してガ ス導入部に挿入接続しているため、ウエハ間の所望の位 躍に、インジェクタの分散口を再現よく設置することは 極めて困難であった。

[0005]

[発明が解決しようとする課題] 本件出願人は、先に、 ガス導入管の基端部側に金属製の保持体を設け、との保 持体をマニホールドのガス導入部に、ガス通路を介して 接続した縦型熱処理装置を提案している(特願2000 -37355)。との装置は、加熱されているマニホー ルドの熱伝達と反応用ヒータからの熱輻射によって金属 製の保持体を昇温させるものである。

【0006】しかし、保持体を加熱する場合。マニホー ルドからの熱伝遾と反応用ヒータからの熱輻射だけでは 不充分な場合がある。そこで、本発明者等は、上記の熱 **伝達手段に加えて、処理容器のプロセスヒータからの熱** エネルギに着目し、この熱エネルギの熱伝達をガス導入 管の基端部側に伝達させて、昇温させる画期的な技術を 40 開発するに至った。

【0007】本発明は、上記の実情に鑑みて開発したも のであり、その目的とするところは、ガス導入管の基端 部側における処理ガスの凝縮を確実に防ぎ、また、ガス 導入管の位置精度と再現性を良好ならしめた熱処理装置 と熱処理方法を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた め.請求項1に係る発明は.被処理体を収容した処理容 器内にガス導入管により処理ガスを導入して熱処理を施

けたガス導入管の基端部を保持し、この保持位置に熱伝 導率の高い熱伝導部材を設け、この熱伝導部材は、前記 処理容器内を加熱する熱エネルギの伝達位置に配設され た熱処理装置である。

【0009】請求項2に係る発明は、ガス導入管の基端 部にガス通路を有する金属製又は石英、SiC等のセラ ミック製の保持体を設け、との保持体に前記熱伝導部材 の下端部を装着した熱処理装置である。

【0010】請求項3に係る発明は、熱伝導部材は 処 理容器内を熱処理温度まで加熱しても金属汚染のおそれ 10 がなく。熱伝導率の高い材料を用いた熱処理装置であ る。この場合、熱伝導部材は. SiC製が好ましい。

【0011】調求項5に係る発明は、処理容器の下端部 に金属製のマニホールドを設け、とのマニホールドに設 けたガス導入部に前記保持体の接続部を接続すると共 に、保持体に形成した挿着部に前記熱伝導部材の下端部 を挿着した熱処理装置である。

【0012】請求項6に係る発明は、熱伝導部材をロッ ド又はバー形状等の棒状物に形成し、この熱伝導部材を 前記保持体の挿着部に立設すると共に、この熱伝導部材 は、前記ガス導入管の長さ方向に近接させた熱処理装置 である.

【0013】請求項7に係る発明は、彼処理体を収容し た処理容器内にガス導入管により処理ガスを導入して熱 処理を施すようにした熱処理方法において、前記ガス導 入管の基端部に設けた熱伝導率の高い熱伝導部材に対し て、前記処理容器内を加熱する熱エネルギを熱伝達さ せ、更に、この熱伝導部材の熱伝導によりガス導入管の 基端部を加熱するようにした熱処理方法である。

【0014】請求項8に係る発明は、ガス導入管の基端 部に設けたガス通路を有する金属製又は非金属製の保持 体を設け、この保持体に棒状の熱伝導部材を装着して、 熱伝導部材の熱伝導により保持体を加熱するようにした 熱処理方法である。この場合、熱伝導部材は、SiC製 が好ましい。

[0015]

[発明の実施の形態] 本発明における縦型の熱処理装置 とその処理方法の好ましい実施形態を図面に従って詳述 する。図1は、縦型熱処理装置の一例を示した縦断正面 図であり、図2は図1の要部拡大断面図、図3は図2の 40 一部拡大断面図である。

【0016】図1乃至図3において、1は半導体ウエハ ₩などの被処理体を収容して所定の熱処理例えば減圧C VDを施すための処理容器であり、本例における処理容 器 1 は、石英製の縦長の反応管であり、この反応管 1 に は、下端開口にフランジ部6が形成され、フランジ部6 の下部には、ガス導入部2を有するステンレス鋼等の金 属製又はSiC等の非金属製のマニホールド3が設けら れている。反応管1内のウエハWには、マニホールド3 のガス導入部2からステンレス鋼。インコネル。モリブ 50 9に回転導入部22を介して回転テーブル23を設け、

デンなどの金属製又はSiC、石英等の非金属製の保持 体4及び石英製のガス導入管(インジェクタ)5により 処理ガスが供給される。この反応管 1 内に設けたガス導 入管5の基端部が保持され、この保持位置に後述する熱 伝導部材29が配設されている。ととにおいて、基端部 とは、反応管1の下方の低温領域であり、特に、ガス導 入部2とガス導入管5の下方部分とが接続される位置を いう。なお、被処理体は、ガラス基板等であっても良 く、また、本発明における熱処理装置は、CVD以外 に、例えば酸化、拡散、アニール等の処理であっても良 い。更に、本例における反応管1は、図1に示すように 単管構造であるが、外管と内管とから成る二重管構造で あっても良い。

[0017] このマニホールド3は、上端部に反応管1 のフランジ部6を載置してフランジ押え7により接合支 持するための支受部8が形成されている。また、マニホ ールド3の側部には、ガス供給配管を接続するガス導入 部2と、排気配管を接続するための排気部9とが形成さ れている。ガス導入部2以外に、ガス導入部10を設け ても良く。このガス導入部10は、ガス種に応じて複数 形成する場合もある。更に、排気配管(図示しない)に は、反応管 1 内を所望の滅圧ないし真空度に制御可能な 減圧制御機構 (図示しない) が設けられている。

[0018]マニホールド3の内周には、円筒状の背の 低いライナー管11を支持するための支持部12が設け **られている。このライナー管11は、ウエハ₩のアンロ** ード時に、排気部9の排気口を隠し、パーティクルの飛 散を防止するものである。また、支持部12は、マニホ ールド3の内周に固定された外リング13と、との外リ 30 ング13の内周に下方から着脱可能に係合される内リン グ14と、この外リング13と内リング14との間を被 覆する下リング 15 をネジ止めを介して着脱可能に取付 けられている。この支持部12が分解可能に構成されて いるので、洗浄、交換等が容易にできるようになってい

【0019】マニホールド3は、反応管1を下方から挿 **入可能な開口部16を有するベースプレート17の下部** に図示しない取付部材を介して取付けられている。ま た。このベースプレート17の上部には、反応管1内を 所定の温度に加熱制御可能な円筒状のヒータ18が設置 されている。なお、ガス導入部2を含むマニホールド3 の外周に図示しない加熱手段を設けている。

[0020] マニホールド3の下端閉口には、ステンレ ス鋼等の金属製蓋体19により気密に閉塞されるように なっている。蓋体19の上部には、例えば150枚程度 にウェハ₩を水平状態で上下方向に所定間隔で支持搭載 する石英又はSiC製のボート20が炉口の断熱手段で ある石英製の保温筒21を介して載置されている。との 場台、ウエハ♥を面内均一に熱処理するために、蓋体Ⅰ

との回転テーブル23上に保温筒21を介してボート20を載置するように構成されている。この蓋体19は、開閉とボート20等の撤入撤出を行うための図示しない 昇降機構の昇降アームに取付けられる。

【0021】マニホールド3には、図5に示すように、ガス導入管5を保持するためブロック状の保持体4を支持部12を介して設けられ、この保持体4には、ガス導入部2とガス導入管5を連通するガス通路24が形成されている。保持体4は、固定部材である取付ネジ25を介して支持部12に着脱可能に取付固定されている。ま 10た、保持体4は、マニホールド3の内側からガス導入部2に挿入接続される接続部26と、ガス導入管5の基端部分を上方から差し込んで保持する保持部27とを備えている。

【0022】ガス導入部2の内周面には、保持体4の一端から突出形成された接続部26の外周部に密着して真空シールするための耐熱性0リング27aが設けられている。この保持部27は、保持体4の他端中央に垂直(上下方向)に貫通した円筒状に形成されている。また、ガス通路24は、接続部26の先端からその軸心部20を通って保持部27の円筒内まで貫通している。

【0023】また、保持体4には、保持部27の垂直方 向に沿って貫通された二つの挿着部28が設けられ、と の挿着部28は、垂直方向に円筒内まで貨通している。 との挿着部28には、後述する熱伝導部材29の下端部 を挿着している。本例においては、図5及び図8に示す ように、熱伝導部材29は、プロセス温度まで加熱して も金属汚染のおそれがなく、熱伝導率の高い材料である SiC製の棒状物で構成されている。また、この熱伝導 部材29は、図8に示すように、ロッド又はバー形状の 30 枠状物29aの下端に縮径した挿入部29bを形成し、 この挿入部29bを保持体4の挿着部28に挿入して立 設させている。この挿入部29bの外径と挿着部28の 内径は、可能な限り近接するように精度加工されて、熱 伝導性を良好にしている。なお. SiC製以外の熱伝導 部材29には、アルミナ等の各種セラミックを選択する ことができるが、何れにしても、金属汚染がなく、熱伝 導性に優れた材料であることが必要である。

【0024】また、ガス導入管5は、図6に示すように、下端部を閉塞させた直管の途中を逆U字形状に折り 40返して形成し、この折返し管部5 aには、ウエハWの被処理面ないし面間に平行に処理ガスを噴射するガス噴出孔30を形成し、下方の管壁には、ガス通路24と対向連通するガス導入口31が形成されている。このガス噴出孔30は、ガス導入管5の長軸方向に沿って適宜間隔で形成されている。なお、本例におけるガス導入管5は、逆U字形の折返し管形状の構成を用いているが、これに限定されることなく、ガス噴出孔を形成した直管形状のガス導入管であっても良く。その他上端がガス噴出口として開口した単なるストレート管であっても良い。 50

799 Z O O Z Z Z Z Z Z Z Z

【0025】ガス導入管5の基端部側は、ガス導入管5の外径よりも若干小さい外径の差込み部32が形成され、この差込み部32の径端の飼状段部33が保持部27の上端開口部に当接させるようにして、ガス導入管5が保持部27を通り抜けて下方へ脱落しないようにしている。この場合、ガス導入管5の差込み部32と保持部27の隙間から処理ガスが漏れ難くするために、ガス導入管5の差込み部32の外径と保持部27の内径を可能な限り近接するように精度良く加工されている。

[0026]また、保持部27には、ガス導入管5の抜け止め手段である抜け止めピン或はネジ34が側部穴27aから挿着部28を通って保持部27の円筒内に突出するように着脱可能に取付けられ、一方、ガス導入管5の基端部には、抜け止めネジ34が係合する凹状の係合満部35が形成されている。これによって、処理ガスのガス圧でガス導入管5が保持部27から上方へ飛び出すことを防止している。

【0027】次に、上記実施形態の作用を説明する。昇降機構により蓋体19を上昇させてボート20及び保温筒21を反応管1内に搬入すると共に、炉口を密閉し、先ず、排気部9の排気配管を介して反応管1内に不活性ガス(例えばN2ガス)を導入して反応管1内を不活性ガスで置換する。

【0028】次いで、ヒータ18の作動により、反応管1内のウエハWを所定の熱処理温度に加熱昇温させると共に、ガス供給管からガス導入部2の保持体4及びガス導入管5を介して反応管1内のウエハW間に所定の処理ガスを供給し、所定の熱処理例えば減圧CVDによる成膜処理を行う。

[0029]即ち、本例においては、処理ガスとして、 ストロンチウム、チタン錯体をTHF溶媒に溶かして気 化させたガス材料を反応管 1 内へ導入し、成膜処理を行 う。このとき、反応管1内は、ヒータ18により、37 5~450℃程度に加熱されているが、反応管1内のガ ス導入管5の基端部側は、比較的低温である。この場 合、金属製の保持体4は、熱伝導部材29を配設しない と、マニホールド3からの熱伝導と、ヒータ18からの 熱輻射によって、図3に示す温測ポイント T は250℃ であった。一方、本例において、保持体4 に熱伝導部材 29を配設すると、反応管1内の熱エネルギが保持体4 に熱伝導され、しかも、熱伝導部材29は、ガス導入管 5の基端部に近接されているから、熱伝導部材29から ガス導入管5に熱輻射されるため、図3に示す温測ポイ ントTでの実測値は280℃であった。従って、ガス導 入管5における基端部を30℃まで昇温することができ た。本例におけるSiC製の熱伝導部材29の熱伝導率 は、170W/(m・K) である。

[0030] 熱処理終了時に、処理ガスの供給を停止 し、不活性ガスを導入して反応管1内を不活性ガスで置 50 換した後、反応管1内を常圧に復帰させてから蓋体19 7

を降下させてボート20及び保温筒21を反応管1内か ら搬出すれば良い。

【0031】このように、ガス導入管5の基端部に設けた熱伝導率の高い熱伝導部材29に対して、反応管1内を加熱する熱エネルギを熱伝達させるため、熱伝導部材29の熱伝導により、保持体4を昇温加熱することができる。

【0032】また、マニホールド3に支持部10を介して保持部28にガス導入管5を取付けるため、Oリングを介してガス導入管を取付けていた従来の構造と異なり、ガス導入管5を安定状態に正確に取付けることができ、特に、分散型ガス導入管5においては、ガス噴出孔30をウエハW間に常に正確に位置決めすることができ、再現性の向上が図れる。

[0033]

[発明の効果]以上のととから明らかなように、 請求項1 に係る発明によると、ガス導入管の基端部を所望の温度まで加熱することができ、そのため、ガス導入管の基端部側における処理ガスの凝縮を確実に防止することができる。

【0034】請求項2に係る発明によると、効率的に金属製の保持体が加熱され、処理ガスの凝縮を防ぐことができると共に、ガス導入管を商精度に再現性よく設置することができる。

【0035】請求項3に係る発明によると、金属汚染の生するおそれがなく、効率的に熱伝導でき、そのため、 ガス導入管の基端部を所定温度まで加熱することができる。

【0036】 請求項5 に係る発明によると、マニホール ドからの熱伝達と処理容器の熱エネルギからの熱輻射に 30 加えて、熱伝導部材の熱伝導によって保持体を所望温度 まで確実に加熱することができる。

【0037】請求項6に係る発明によると、熱伝導部材は、熱伝導と熱輻射が高精度に熱伝達され、しかも簡単な形状で形成できると共に、熱伝導部材に近接しているガス導入管を輻射熱によって昇温加熱することもできる。

【0038】請求項7に係る発明によると、処理容器内

8

の加熱エネルギを熱伝導部材によって熱伝導することによりガス導入管の基端部を加熱する熱処理方法であるため、ガス導入管基端部側における処理ガスの凝縮を確実 に防止することができる。

【0039】請求項8に係る発明によると、マニホールドからの熱伝達と処理容器の熱輻射だけでは加熱温度が不足な場合でも、熱伝導部材の熱伝導を加えることが可能となり、保持体を所望の温度まで加熱する方法を提供することが可能となる。

10 [0040]

【図面の簡単な説明】

[図1] 本発明における縦型熱処理装置の一例を示した 縦断正面図である。

【図2】図1の要部拡大断面図である。

【図3】図2の一部拡大断面図である。

【図4】図3の縦断側面図である。

[図5] (a) は保持体の左側面図. (b) はその平面図. (c) はその正面図. (d) はその底面図. (e) は(c) の縦断面図である。

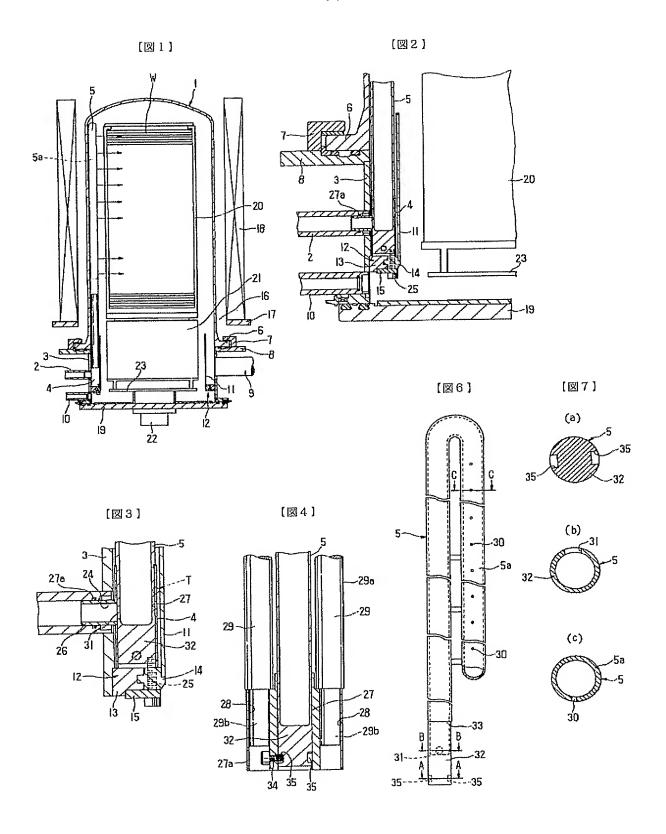
20 【図6】図1に示したガス導入管の一部切欠き正面図である。

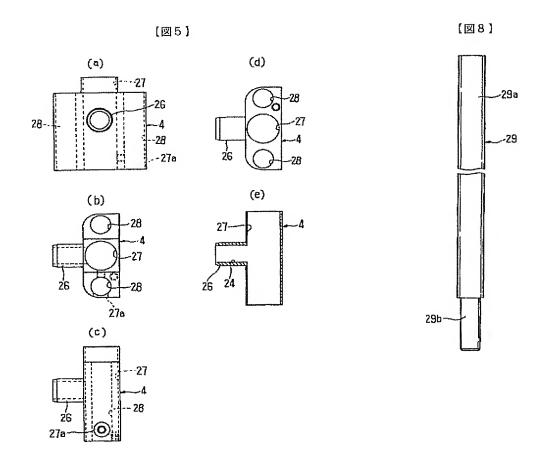
【図7】(a)は図6のA-A線断面図、(b)は図6のB-B線断面図、(c)は図6のC-C線断面図である。

【図8】図1に示した熱伝導部材の一部切欠き正面図である。

【符号の説明】

- 1 処理容器(反応管)
- 2 ガス導入部
- 30 3 マニホールド
 - 4 保持体
 - 5 ガス導入管
 - 18 ヒータ
 - 26 接続部
 - 27 保持部
 - 28 挿着部
 - 29 熱伝導部材
 - W 被処理体(半導体ウエハ)





フロントページの続き

(72)発明者 長谷部 一秀

東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBS放送センター 東京エレクトロン株式会社内

(72)発明者 梅原 隆人

東京都港区赤坂五丁目3番8号 TBS放送センター 東京エレクトロン株式会社内

F ターム(参考) 4K061 AA01 BA11 CA00 CA08 DA05

4K063 AA05 AA12 AA15 AA19 BA12 CA03 DA13 DA26

5F045 AB40 BB15 DQ04 EB02 EB03 EC07 EF01 EN05